#### Міністерство освіти і науки України КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРССИТЕТ

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю Група ПМ-11

## ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

### ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

# Дослідження характеристик і параметрів первинних засобів автоматизації на прикладі резистивного перетворювача

Керівник	(підпис)	д.т.н., проф. Черепанська І. Ю. (дата)
Виконавець	(підпис)	Погорєлов Б. Ю.

## Лабораторна робота №3

# Тема роботи

Дослідження характеристик і параметрів первинних засобів автоматизації на прикладі резистивного перетворювача

# Мета роботи

Вивчити будову, принцип дії та основні характеристики первинних засобів автоматизації на прикладі резистивного перетворювача (терморезистора). Навчитися складати електричні принципові схеми їх підключення.

# Обладнання та інструменти

- Термостат та кип'ятильник для підігріву води.
- Спиртовий термометр для вимірювання температури води у термостаті.
- Платиновий терморезистор (WZP PT100).
- Прилад для вимірювання опору (мультиметр Digital DT9205A).
- З'єднувальні провідники.

# Порядок виконання роботи

- 1. Ознайомитись з теоретичними відомостями.
- 2. Вивчити будову та принцип роботи термочутливих перетворювачів.
- 3. Вивчити способи підключення резистивних перетворювачів (терморезисторів) та накреслити електричні принципові схеми.
- 4. Провести експериментальні дослідження основних параметрів та характеристик датчика температури.
- 5. Зробити висновки та відповісти на контрольні питання.
- 6. Оформити звіт згідно вимог.

					$\Pi M1109.04.00.03ec{\Pi} P$						
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата							
Роз	роб.	Погорелов Б.Ю				Літ.			Аркуш	Аркушів	
Пер	рев.	Черепанська І.Ю.			Дослідження характеристик і параметріє				2	3	
					первинних засобів автоматизації на						
Н. І	Контр.				прикладі резистивного перетворювача	паді резистивного перетворювача 🛮 КПІ ім. І. Сік				ського, ПБФ	
Зат	В.	Черепанська І.Ю.									

# Експериментальна частина

Терморезистор WZP РТ100 платиновий												
T°C	23	34	40	43	46	50	52	55	60	62		
$R_{\partial i \check{u}_{CHe}}$ , Ом	108,74	112,92	115,2	116,34	117,48	119	119,76	120,9	122,8	123,56		
$R_{eum}$ , Ом	108,8	113,1	115,4	116,3	117,6	118,8	119,8	120,7	122,4	123,4		
$\Delta R = R_{eum} - R$ , Om	0,06	0,18	0,2	-0,04	0,12	-0,2	0,04	-0,2	-0,4	-0,16		
$\Delta R_{npus}, \text{ OM}$ $\Delta R_{npus} = \frac{1.5 \cdot \text{X}_{\text{N}}}{100\%}$	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19		
$\Delta R_{\Sigma}, \text{OM}$ $\Delta R_{\Sigma} = \sqrt{\Delta R^2 + \Delta R_{npun}^2}$	0,17	0,25	0,26	0,18	0,21	0,27	0,18	0,27	0,44	0,24		
$\alpha$		0,0038										
$R_0$ , Om		100										
$\delta = \frac{\delta, \%}{R_{\text{\tiny BLM}}} \cdot 100\%$	0,1598	0,2187	0,2292	0,1539	0,1814	0,2255	0,1537	0,2235	0,3596	0,1983		
$\gamma = \frac{\gamma, \%}{R_N} 100\%$	0,1599	0,2190	0,2296	0,1538	0,1816	0,2251	0,1537	0,2231	0,3584	0,1980		

Рис. 3.1: Результати обчислень

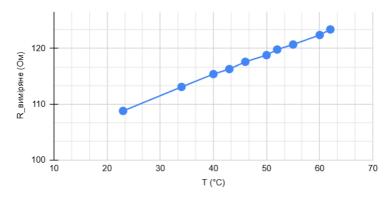


Рис. 3.2: Таблиця залежності опору терморезистора від температури

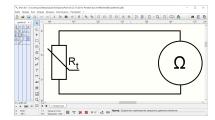


Рис. 3.3: Схема підключення терморезистора

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата